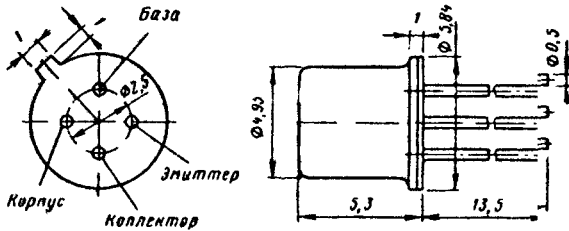


КТ339А

Транзисторы кремниевые эпитаксиально-планарные структуры *p-n-p* уси-
 тельные. Предназначены для применения в усилителях высокой частоты. Вы-
 пускаются в металлоглазном корпусе с гибкими выводами. Тип прибо-
 указывается на корпусе

Масса транзистора не более 0,4 г

КТ339А



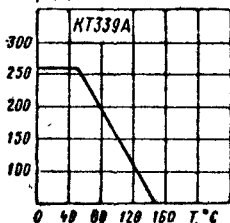
Электрические параметры

Статический коэффициент передачи тока в схеме ОЭ при $U_{КБ} = 10$ В, $I_B = 7$ мА, не менее	25
Коэффициент усиления по мощности при $U_{КБ} = 1,6$ В, $I_K = 7,2$ мА, $f = 35$ МГц, не менее	24 дБ
Граничная частота коэффициента передачи тока при $U_{КБ} = 10$ В, $I_B = 5$ мА, не менее	300 МГц
Постоянная времени цепи обратной связи при $U_{КБ} = 10$ В, $I_B = 7$ мА, не более	25 нс
Емкость коллекторного перехода при $U_{КБ} = 5$ В, не более	2 пФ

Предельные эксплуатационные данные

Постоянное напряжение коллектор — база	40 В
Постоянное напряжение коллектор — эмиттер	25 В
Постоянное напряжение эмиттер — база	4 В
Постоянный ток коллектора	25 мА
Постоянная рассеиваемая мощность коллектора при $T = -60 \dots +50$ °С	260 мВт
Температура <i>p-n</i> перехода	+175 °С
Температура окружающей среды	-60 ... +160 °С

R_{θ} , мксек · Вт



При включении транзистора в цепь, находя-
 щуюся под напряжением, базовый контакт дол-
 жен присоединяться первым и отсоединяться по-
 следним

Расстояние от места изгиба до корпуса тран-
 зистора не менее 3 мм, радиус закругления не
 менее 1,5 мм.

Пайка выводов допускается не ближе 5 мм
 от корпуса транзистора.

Зависимость максимальной допустимой рассеиваемой мощности коллектора от температуры